

Сведения о ведущей организации

по диссертации Рябищенковой Анастасии Геннадьевны
 «Адсорбция, диффузия и интеркаляция немагнитных атомов
 на поверхностях тетрадимитоподобных топологических изоляторов»
 по специальности 01.04.07 – Физика конденсированного состояния
 на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук
Сокращенное наименование организации в соответствии с уставом	ИАПУ ДВО РАН
Место нахождения	Российская Федерация, Приморская область, г. Владивосток
Почтовый индекс, адрес организации	690041, г. Владивосток, ул. Радио, 5
Телефон	(423) 231-04-39
Адрес электронной почты	director@iacp.dvo.ru
Адрес официального сайта	www.iacp.dvo.ru
Список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)	
1.	Mihalyuk A. N. One-atom-layer 4×4 compound in (Tl, Pb) / Si(111) system / A. N. Mihalyuk, C. R. Hsing, C. M. Wei, D. V. Gruznev, L. V. Bondarenko, A. Y. Tupchaya, A. V. Zotov, A. A. Saranin // Surface science. – 2017. – Vol. 657. – P. 63–68. – DOI: 10.1016/j.susc.2016.11.004 (<i>Web of Science</i>)
2.	Ichinokura S. Superconductivity in thallium double atomic layer and transition into an insulating phase intermediated by a quantum metal state / S. Ichinokura, L. V. Bondarenko, A. Y. Tupchaya, D. V. Gruznev, A. V. Zotov, A. A. Saranin, S. Hasegawa // 2D Materials. – 2017. – Vol. 4, is 2. – Article number 025020. – 10 p. – DOI: 10.1088/2053-1583/aa57f9 (<i>Web of Science</i>)
3.	Kotlyar V. G. The (2×2) reconstructions on the surface of cobalt silicides: Atomic configuration at the annealed Co/Si(111) interface / V. G. Kotlyar, A. A. Alekseev, D. A. Olyanich, T. V. Utas, A. V. Zotov, A. A. Saranin // Surface science. – 2017. – Vol. 662. – P. 6–11. – DOI: 10.1016/j.susc.2017.03.010 (<i>Web of Science</i>)
4.	Dozsa L. Mg ₂ Sn heterostructures on Si(111) substrate / L. Dozsa, N. G. Galkin, B. Pecz, Z. Osvath, Z. Zolnai, A. Nemeth, K. N. Galkin, I. M. Chernev, S. A. Dotsenko // Applied Surface Science. – 2017. – Vol. 405. – P. 111–118. – DOI: /10.1016/j.apsusc.2017.01.299 (<i>Web of Science</i>)
5.	Matetskiy A. V. Growth and characterization of van-der-Waals heterostuctures formed by the topological insulator Bi ₂ Se ₃ and the trivial insulator SnSe ₂ / A. V. Matetskiy, I. A. Kibirev, A. V. Zotov, A. A. Saranin // Applied physics letters. – 2016. – Vol. 109, is. 2. – Article number 021606. – 4 p. – DOI: 10.1063/1.4958936 (<i>Web of Science</i>)
6.	Denisov N. V. Bismuth–indium two-dimensional compounds on Si(111) surface / N. V. Denisov, A. A. Alekseev, O. A. Utas, S. G. Azatyan, A. V. Zotov, A. A. Saranin // Surface science. – 2016. – Vol. 651. – P. 105–111. – DOI: 10.1016/j.susc.2016.03.031 (<i>Web of Science</i>)
7.	Matetskiy A. V. Direct observation of a gap opening in topological interface states of MnSe/Bi ₂ Se ₃ heterostructure / A. V. Matetskiy, I. A. Kibirev, T. Hirahara, S. Hasegawa, A. V. Zotov, A. A. Saranin // Applied physics letters. – 2015. – Vol. 107, is. 9. – Article number 091604. – 4 p. – DOI: 10.1063/1.4930151 (<i>Web of Science</i>)

- | | |
|-----|---|
| 8. | Gruznev D. V. Tailoring of spin-split metallic surface-state bands on silicon / D. V. Gruznev, A. V. Zotov, A. A. Saranin // Journal of electron spectroscopy and related phenomena. – 2015. – Vol. 201. – P. 81–87. – DOI: 10.1016/j.elspec.2014.09.006 (<i>Web of Science</i>) |
| 9. | Matetskiy A. V. Two-dimensional superconductor with a giant Rashba effect: One-atom-layer Tl-Pb compound on Si(111) / A. V. Matetskiy, S. Ichinokura, L. V. Bondarenko, A. Y. Tupchaya, D. V. Gruznev, A. V. Zotov, A. A. Saranin, R. Hobara, A. Takayama, S. Hasegawa // Physical review letters. – 2015. – Vol. 115, is.14. – Article number 147003. – 5 p. – DOI: 10.1103/PhysRevLett.115.147003 (<i>Web of Science</i>) |
| 10. | Migas D. B. Electronic properties of Ca ₂ Si silicide: from bulk to nanostructures by means of first principal calculations / D. B. Migas, V. O. Bogorodz, A. B. Filonov, V. L. Shaposhnikov, V. E. Borisenko, N. G. Galkin // Japanese journal of applied physics. – 2015. – Vol. 54, is. 7S2. – Article number 07JA03. – 7 p. – DOI: 10.7567/JJAP.54.07JA03 (<i>Web of Science</i>) |
| 11. | Balashov V. V. Effect of oxygen pressure on the texture of a magnetite film grown by reactive deposition on a SiO ₂ /Si(001) surface / V. V. Balashov, V. A. Vikulov, T. A. Pisarenko, V. V. Korobtsov // Physics of the solid state. – 2015. – Vol. 57, is. 12. – P. 2532–2536. – DOI: 10.1134/S1063783415120070 (<i>Web of Science</i>) |
| 12. | Chou J. P. Atomic structure and electronic properties of In/Si(111)2×2 surface / J. P. Chou, C. M. Wei, Y. L. Wang, D. V. Gruznev, L. V. Bondarenko, A. V. Matetskiy, A. Y. Tupchaya, A. V. Zotov, A. A. Saranin // Physical review B. – 2014. – Vol. 89, is. 15. – Article number 155310. – 5 p. – DOI: 10.1103/PhysRevB.89.155310 (<i>Web of Science</i>) |
| 13. | Tsukanov D. A. Effect of the stoichiometric composition of the Si(111)√21×√21-(Au, Ag) surface phase on substrate conductivity / D. A. Tsukanov, M. V. Ryzhkova, E. A. Borisenko // Semiconductors. – 2013. – Vol. 47, is. 6. – P. 775–781. – DOI: 10.1134/S1063782613060298 (<i>Web of Science</i>) |
| 14. | Luniakov Yu. V. Extra metal adatom surface diffusion simulation on 1/3ML Si(111)√3×√3 metal-induced surfaces / Yu. V. Luniakov // Physica scripta. – 2013. – Vol. 88, is. 3. – Article number 035604. – 8 p. – DOI: 10.1088/0031-8949/88/03/035604 (<i>Web of Science</i>) |
| 15. | Gouralnik A. S. Formation of iron and iron silicides on silicon and iron surfaces. Role of the deposition rate and volumetric effects / A. S. Gouralnik, S. A. Dotsenko, N. G. Galkin, V. A. Ivanov, V. S. Plotnikov, E. V. Pustovalov, A. I. Cherednichenko, A. K. Gutakovski, M. A. Neklyudova // Applied physics A. – 2013. – Vol. 112, is. 2. – P. 507–515. – DOI: 10.1007/s00339-012-7440-2 (<i>Web of Science</i>) |

Верно

Директор Института автоматизации
и процессов управления ДО ВАИ,
академик



Ю. Н. Кульчин

23.01.2018



Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
**ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ
И ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ**
Дальневосточного отделения
Российской академии наук
(ИАПУ ДВО РАН)

ул. Радио, д. 5, Владивосток, 690041
Телефон (423) 2310439, факс (423) 2310452

E-mail: director@iacp.dvo.ru

<http://www.iacp.dvo.ru>

ОКПО 02698217, ОГРН 1022502127878

ИНН/КПП 2539007627/253901001

Председателю диссертационного
совета Д 212.267.07, созданного на
базе федерального государственного
автономного образовательного
учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский
Томский государственный
университет», доктору физико-
математических наук, профессору
Багрову Владиславу Гавриловичу

23.01.2018 года № 16141 / 48

На № _____ от _____

Уважаемый Владислав Гаврилович!

Подтверждаю согласие на назначение Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения науки Института автоматизации и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук ведущей организацией по диссертации Рябищенковой Анастасии Геннадьевны «Адсорбция, диффузия и интеркаляция немагнитных атомов на поверхностях тетрадимитоподобных топологических изоляторов» по специальности 01.04.07 – Физика конденсированного состояния на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации о ведущей организации в автореферат диссертации А.Г.Рябищенковой и для размещения на сайте ТГУ, прилагаются.

Директор института
Академик

Ю.Н. Кульчин